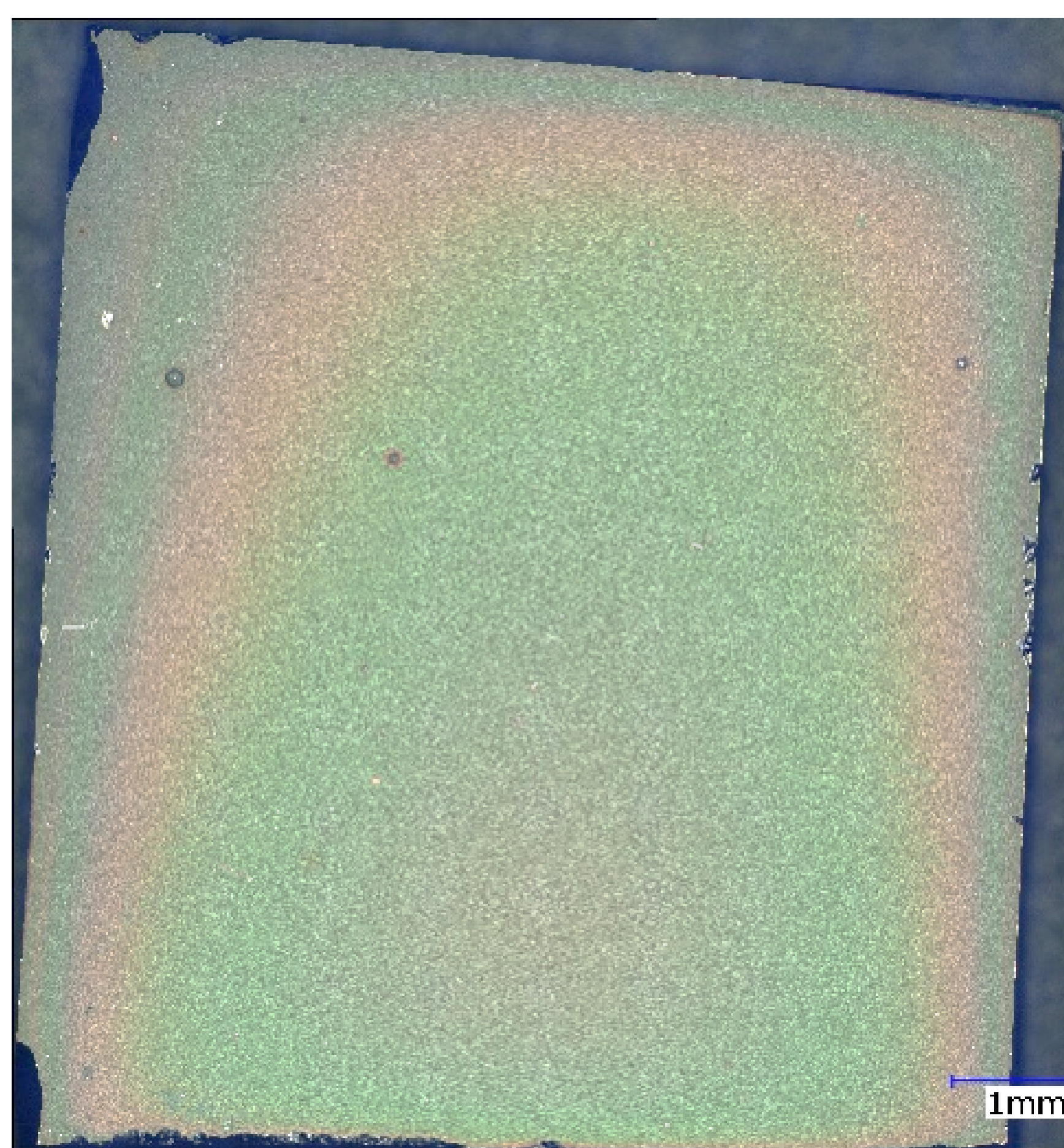


立命館大学発ベンチャー



# PATENTIX



Si(100)基板上の導電性バッファー層上に  
成膜されたr-GeO<sub>2</sub>の外観写真

# 「世界初」 Si基板上への r-GeO<sub>2</sub>薄膜の作製に成功。

～次世代半導体材料r-GeO<sub>2</sub>を安価に実現する道を拓く～

